水中に懸濁した微粒子の凝集分散:基礎理論とその適用性

小林 幹佳

1. はじめに

水中に浮遊懸濁している大きさが数nmから 数μmの範囲にあるコロイド粒子は、周りの環 境条件に応じて互いに凝集してフロックと呼ば れる凝集体を形成したり、反発しあって個々の 粒子として存在したりする。前者の状態を凝集 状態といい、後者を分散状態という。分散状態 はコロイドが安定状態にあることに相当する。 コロイドの分散凝集状態を制御することは実用 上、重要である。水処理などの固液分離におけ る凝集操作では、濁りの成分である粘土や有機 物といった微細なコロイド粒子を互いに凝集さ せて大きなフロックを形成させることにより、 沈降による分離が促進される"。一方、塗料な どではいかにして顔料粒子を分散状態にするか が重要となる²。

水中のコロイド粒子の凝集分散を議論する上 では、粒子が持つ荷電に起因する静電的反発力 を適切に評価する必要がある。高分子(電解質) を添加した場合には、静電効果に加えて、立体 安定効果や架橋凝集も大きな役割を果たす^{3,4}。 実際の工業プロセスでは多くの技術的ノウハウ が蓄積されているが、コロイド粒子の凝集分散 メカニズムや動的プロセスについてはまだ不明 な点も残されている。水溶性高分子が関与する

2010年 9 月13日受付 KOBAYASHI Motoyoshi 岩手大学 農学部 (〒020-8550 岩手県盛岡市上田 3-18-8) TEL 019-621-6190 凝集のダイナミクスについては足立による総 説³⁰ がある。本稿では単純な塩添加が水溶液中 に分散した帯電コロイド粒子の凝集分散に及ぼ す効果を考察する上での基本となる DLVO 理 論⁶⁰ と関連する事項について解説し、それらの 代表的な球状モデル粒子であるラテックスとシ リカへの適用性について議論する。

2. 凝集過程の表現

水中のコロイド粒子はブラウン運動による拡 散や流れにより絶えず運動している。運動の結 果、粒子間に相対的な速度差が生じると粒子同 士は衝突する(Fig. 1)。衝突の際に、粒子間 に作用する引力が十分に大きければ、粒子同士 は凝集する。この過程が順次繰り返されること により、多数のコロイド粒子からなる様々な大 きさのフロックが形成される。凝集過程は凝集 Figures



Fig.1 粒子の衝突様式の模式図。



Fig. 2 凝集に伴う粒子の数と大きさの変化の 様子を表した模式図。

にともなうフロック径の分布の経時変化と捉え ることができる(Fig. 2)。スモルコフスキー[®] は、凝集が大きさの均一なコロイド粒子からな るフロック間の2体衝突によって進行すると考 え、凝集過程を式(1)のように表現した。

$$\frac{dn_k}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{\substack{i=1\\i+i=k}}^{i=k-1} k_{ii} n_i n_j - n_k \sum_{j=1}^{\infty} k_{kj} n_j \qquad (1)$$

ここで n_k はある時刻tにおけるk 個の粒子からなるk次フロックの数濃度、 k_i はi次フロッ クとj次フロックの凝集速度定数である。式 (1)の右辺第一項は凝集によるk次フロックの形成を、第二項は凝集によるk次フロック の形成を、第二項は凝集によるk次フロック の消滅を意味している。式(1)中の凝集速度定 数 k_i は粒子間の衝突様式と物理化学的相互作 用によって決まる。なお式(1)では、一旦、形 成されたフロックは決して壊れないことが想定 されている。

凝集速度定数 ku を適切に評価し、すべての $k(=1, 2, 3, \cdots)$ について式(1)を解くことによ り、任意の時刻におけるフロックの大きさの分 布を求めることができる。しかしながら実際に は、以下の2つの理由のため、この実施は困難 となっている。1つは現実的なフロックは多数 の1次粒子から構成されており、これを式(1) で表現するには膨大な数の式を解く必要がある 点である。もう1つの困難な点は、現在のとこ ろ、物理化学ならびに流体力学的な相互作用を 厳密に考慮した凝集速度定数は、剛体球間の凝 集に対してのみしか得られていない点である。 実際の固体粒子の凝集の結果として形成される フロックは空隙を持つかさばった構造をしてお り、フロック構造はフラクタル次元を用いて表 現される。フロック間の衝突過程や相互作用 については直観的に得られた式やフィッティン グ関数による取り扱いがなされているが、不明 瞭な点も多く残されている。フロック間の凝集 過程を明らかにすることは実用的にも学術的に も非常に重要な課題であり、今後さらなる研究 を必要とする。以下では、フロック間の凝集は 考えず、厳密な理論に基づいた解析が可能な凝 集の初期段階を扱う。

大きさの揃った粒子からなる分散系における 凝集の初期段階においては、存在する粒子のほ とんどは1次粒子と2次粒子であると考えるこ とができる。この場合には、1次粒子と2次粒 子の濃度変化のみを考慮すれば良く、扱う式は 以下の2つになる"。

$$\frac{dn_1}{dt} = -k_{11}n_0^2 \tag{2}$$

$$\frac{dn_2}{dt} = \frac{1}{2}k_{11}n_0^2$$
 (3)

ここで n_0 は初期粒子数濃度、 k_1 は1次粒子間 の凝集速度定数である。あるいは初期段階では、 速度定数 k_i をすべて k_1 で近似できると仮定し、 すべての次数 $k(=1, 2, 3, \dots \infty)$ について式(1) を足し合わせることにより、全粒子濃度 $N(t) = n_1 + n_2 + n_3 + \dots \infty$ の経時変化が次のよう に書ける⁸⁰。

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\frac{1}{2}k_{11}N(t)^2$$
 (4)

基礎的研究では、式(2)と(3)あるいは式(4) による解析から ku の妥当性を検討する事例が 多い。

ブラウン運動による凝集速度定数と 粒子間相互作用

コロイド分散系全体が静止していても、粒子 同士はブラウン運動により衝突する。スモルコ フスキー[®]は、ブラウン運動による粒子の拡散 フラックスを計算することにより、最も基本と なる凝集速度定数を導いた。ブラウン運動によ る拡散に加えて、粒子間相互作用のポテンシャ ルエネルギー勾配に起因する力によっても粒子 は運動する。さらには粒子同士が凝集する寸前 まで近付きあうと、凝集を阻害する流体力学的 相互作用が発生する。これらをすべて考慮した 場合、半径 R の同種の固体粒子間の凝集速度 定数は次のように書ける[®]。

$$k_{11} = \left\{ 2R \int_{0}^{\infty} \frac{B(h)}{(2R+h)^2} \exp\left[\frac{V(h)}{k_B T}\right] dh \right\}^{-1} \frac{8k_B T}{3\mu}$$
(5)

ここで k_B はボルツマン定数、Tは絶対温度、 μ は粘性係数、B(h)は粒子間の流体力学的相互作用を表す関数、V(h)は粒子間の物理化学的な相互作用ポテンシャル、hは粒子表面間距離である。流体力学的相互作用を表す関数B(h)は近似式により

$$B(h) = \frac{6(h/R)^2 + 13(h/R) + 2}{6(h/R)^2 + 4(h/R)}$$
(6)

と書ける。

通常、コロイド粒子の表面は帯電しており、 溶液中の対イオンを引きつけて拡散電気二重層 を形成する。同種のコロイド粒子同士が近付き あい、拡散電気二重層が重なりあうと、反発的 な電気二重層(EDL)力が発生する。一方、粒 子間には普遍的に van der Waals (vdW) 力に 起因する引力が作用している。Derjaguin と Landau、Verwey と Overbeek は、コロイド粒 子間の相互作用のポテンシャルエネルギーは vdW ポテンシャル V_{vdW} と EDL ポテンシャル V_{edl} との和 ($V = V_{vdW} + V_{edl}$)によって表される、 とする理論を提案した。この理論は彼らの頭文 字をとって DLVO 理論と呼ばれる。DLVO 理 論のポテンシャルエネルギーは種々の仮定のも とに導かれており、様々な関数形が存在する。 厳密な計算に基づく EDL 相互作用ポテンシャ ルを陽的に表すことはできないので数値計算が 必要となる。代表的な近似解析解としては、半 径 R の同種の球粒子について、以下のような 式がある"い。

$$V_{vdw}(h) = -\frac{AR}{12h} \tag{7}$$

$$V_{\text{edt}}(h) = \frac{64\pi Rnk_B T}{\kappa^2} \gamma^2 \exp(-\kappa h), \gamma$$
$$= \tanh\left(\frac{ze\Psi_0}{4k_B T}\right) \tag{8}$$

$$V_{edt}(h) = \frac{2\pi R \varepsilon_r \varepsilon_0 \Psi_0^2}{\Delta} \ln[1 + \Delta \exp(-\kappa h)]$$
(9)

$$\kappa^{-1} = \left(\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 k_B T}{2N_A e^2 I}\right)^{\frac{1}{2}}$$
(10)

ここでA は vdW 力に起因する粒子間引力の尺 度であるハマカー定数、e は電気素量、z はイ オンの価数、n は電解質濃度、 $\varepsilon_{r}\varepsilon_{u}$ は誘電率、 Ψ。は表面電位(拡散層電位)、NA はアボガド ロ数である。κはデバイのパラメータとよばれ、 溶液のイオン強度 I に依存する。κ の逆数 1/κ は長さの次元を持ち、拡散電気二重層の厚さの 指標とされている。式(8)は陽イオンと陰イオ ンの価数がともに z である z:z 型の対称電解質 の溶液中における相互作用を対象とし、粒子同 土が近付きあっても表面電位は一定であること と表面間の真ん中の位置における電位が低いこ とが想定されている。一方、式(9)は表面間の すべての位置における電位が低いときに妥当で あるが、任意の電解質組成に対して適用できる こと、表面が近付きあったときに表面電荷や表 面電位が変化する荷電調節(charge regulation) がパラメータ∆によって考慮されている点に 特徴がある。パラメータ∆は-1から1の間の 値をとり、 $\Delta=1$ の時は電位一定であり、 $\Delta=$ -1の時は電荷一定に相当する。Vww が物質に よって決まる一方、Vedl は溶液のイオン強度I と粒子の表面電位 ¥% によって変化する。

DLVO 理論によって計算された全相互作用 のポテンシャル曲線(ポテンシャルエネルギー と表面間距離の関係)を Fig. 3 に示す。イオ ン強度が低く、表面電位が高いときには、粒子 表面間の距離が短いときにエネルギーの障壁が 存在し、粒子同士が近付きあうことを阻害する。 反対に、イオン強度を高くしたり表面電位を低 くすると、エネルギー障壁は低くなり、引力的 な vdW ポテンシャルが支配的になる。結果と





して、高いイオン強度あるい低い表面電位にお いて、粒子は衝突すると凝集することになる。 イオン強度は調節可能なので、DLVO 理論に よって粒子の凝集分散を検討するためには、粒 子の表面電位を適切に評価する必要がある。 DLVO 理論により粒子間相互作用ポテンシャ ルが計算できれば、式(5)により凝集速度定数 の計算が可能になる。

4. コロイド粒子の帯電

DLVO 理論に基づいて凝集速度を見積もる ためには、粒子の表面電位を知る必要がある。 しかし現在、コロイド粒子の表面電位を直接測 定することは困難である。そのため、電気泳動 などの界面動電現象の測定から得られる電位 (いわゆるゼータ電位)を評価したり、電位差 滴定や電気伝導度滴定によって評価できる表面 電荷密度から理論的に表面電位を推定したりす る方法がとられる^{& 10. 12. 13)}。

電気泳動の実験では、コロイド粒子分散系に 電場 E をかけて誘発されるコロイド粒子の移 動速度 u を測定することで、電気泳動移動度 $\mu_m = u/E$ が得られる。この移動度 μ_m は理論解 析を通してゼータ電位 ζ と結び付けられる。表 面電位が低く拡散電気二重層が薄いときに使用 できる古典的な近似解として、次のスモルコフ スキーの式^{11, 13)}

$$\mu_m = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0}{\mu} \zeta \tag{11}$$

があり、よく使用されている。

より厳密な計算によれば、電気泳動している 粒子周りの拡散電気二重層は変形し緩和効果を 引き起こす (Fig. 4)。Kim らのシミュレーショ ンは拡散電気二重層の変形の様子を表してい る¹⁴⁾。緩和効果のために、電気泳動移動度とゼー タ電位の関係は式(11)のような線形関係にはな らない。Fig. 5 の通り、移動度はゼータ電位の 増加とともに増加し、やがて極大に達し、減少 するようになる。このことは、ゼータ電位から 移動度を推定することは可能であるが、移動度 からゼータ電位を評価することは原理的にでき ないことを意味する。ゼータ電位から電気泳動



Fig. 4 電気泳動している負に帯電した粒子まわり の拡散電気二重層の緩和の様子の模式図。



9.0 電気(小助将動度)にで、)電位の(A)(ホッス モルコフスキー理論(直線)と緩和効果 を考慮した理論(曲線)。

移動度を求める際には Ohshima の近似解析解 や O'Brien と White の計算プログラムを使用 できる^{13, 15)}。

電位差滴定や電導度滴定などにより表面電荷 密度σを得ることができれば、表面電位(拡 散層電位)Ψ。は拡散電気二重層理論に基づく 次式により計算される^{10,11}。

$$\sigma = \frac{2k_B T \varepsilon_r \varepsilon_0 \kappa}{ez} \sinh\left(\frac{z e \Psi_0}{2k_B T}\right) \tag{12}$$

この式は溶液中の電解質が z:z 型電解質である 場合に使用できる。式(12)によって算出された 表面電位が妥当であるかどうかは、表面電位か らゼータ電位と電気泳動移動度 μ_m を理論によ り計算し、 μ_m の測定結果と比較することで判 断できる。ゼータ電位 ζ の値を計算で求める場 合、z:z 型電解質の水溶液中においては、拡散 電気二重層内の電位分布を記述する次式が使用 される^{10, 10}。

$$\zeta = \frac{4k_BT}{ze} \operatorname{arctanh}\left[\exp(-\kappa x_s) \operatorname{tanh}\left(\frac{ze \Psi_0}{4k_BT}\right)\right]$$
(13)

式(13)中の x_s は表面からゼータ電位が定義さ れるすべり面までの距離である。すべり面と表 面との間には流体力学的に不動の層が存在する と考えられる¹³ (Fig. 6)。



Fig. 6 すべり面とゼータ電位の関係を表した 模式図。

ゼータ電位の測定は表面が正に帯電している か負に帯電しているかを判断したり定性的な電 位の大小を議論したり上では有効である。しか しながら、表面からすべり面までの距離 x,の 推定や拡散電気二重層の緩和の問題があるため、 定量的な解釈には注意を要する。荷電特性の評 価においては、電気泳動移動度の測定に加えて 表面電荷密度の測定を併せて行うことが望まし い。

5. DLVO 理論から予測される凝集挙動

以上のようにコロイド粒子の荷電特性を適切 に評価することができれば、DLVO 理論によ り凝集速度の定量的な解析が可能になる。 DLVO 理論に基づいて計算した凝集速度定数 の例を Fig. 7 に示す。Fig. 7 の通り、凝集速 度定数 k_u は電解質濃度の増加とともに急激に 増加し、やがて急速凝集速度定数と呼ばれる一 定値 kh になる。また kh を基準とした相対的 な凝集速度である安定度比 W

$$W = \frac{k_{\rm in}^{\prime}}{k_{\rm in}} \tag{14}$$

は伝統的に凝集挙動を議論する際に良く用いら れる^{18, 17, 18)}。Fig. 8 に 安定度比の計算結果を示 す。当然ながら安定度比の最小値は1であり、 速度定数を逆さにしたグラフになる。凝集速度



Fig. 7 DLVO 理論による凝集速度定数 k₁₁ の計 算値。



Fig.8 DLVO 理論による安定度比 W の計算値。

が遅いと安定度比は大きくなる。これは凝集速 度が遅くコロイド粒子が小さいままであれば、 凝集沈降により分離する粒子はほとんどないの で、分散系全体はコロイド的に安定となること と対応する。DLVO 理論によれば安定度比は 次式で計算される。

$$W = \frac{\int_{0}^{\infty} \frac{B(h)}{(2R+h)^2} \exp\left[\frac{V(h)}{k_B T}\right] dh}{\int_{0}^{\infty} \frac{B(h)}{(2R+h)^2} \exp\left[\frac{V_{vdW}(h)}{k_B T}\right] dh}$$
(15)

度比)が電解質濃度に依存する領域を緩速凝集 領域、電解質濃度によらず一定になる領域を急 速凝集領域、両者の境界の濃度を臨界凝集濃度 (ccc あるいは cfc)という^{11.16.18)}。緩速凝集領域 では、電解質濃度の増加により粒子間の電気二 重層(EDL)斥力が減少するため、凝集速度は 増加(安定度比は低下)する。急速凝集領域で はEDL斥力は遮蔽され、凝集速度定数は粒子 間の衝突頻度と van der Waals 相互作用によっ て決まる急速凝集速度定数 kh (安定度比は1) になる。対象とするコロイド分散系が急速凝集 域にあるか緩速凝集域にあるかは実用上、重要 なポイントである。なお、溶液の pH により表 面電位が変化する場合には凝集速度(安定度比) の pH 依存性も計算可能である^{8.10}。

DLVO 理論は、経験的に知られていた急速 凝集領域、緩速凝集領域、cccの存在を説明し、 さらに、価数の大きなイオンほど ccc が小さく なるというシュルツ・ハーディー則として知ら れる経験則をも説明することができた^{10, 11, 10}。 このように DLVO 理論は様々な凝集挙動を定 性的に説明し大きな成功を収めた。その一方、 より詳細にみると、緩速凝集領域における安定 度比 W の電解質濃度 C への依存性 dlogW/ dlogC について、実験と理論との間に定量的 に大きな差異が見出されていた^{10, 11, 16, 18)}。すな わち、理論では dlogW/dlogC は粒子径に依存 するはずなのに実験ではそのような傾向は認め られないこと、理論の傾き dlogW/dlogC は急 であるのに実験のそれは緩やかであることであ る。この緩速凝集領域における理論と実験の不 一致は古くから知られ、解決すべき DLVO 理 論の矛盾として長い間取り残されてきた。一方、 近年になり発達してきた表面間力の直接測定に より、表面間の距離が数 nm 以下になる近距離 を除いて、DLVO 理論は表面間力と距離の関 係をよく再現することが明らかになった¹⁰。

6. 凝集速度定数の実験による評価

6.1 粒子数の直接カウント

実験により、コロイド粒子の数濃度の絶対値



Fig. 9 コールターカウンターにより測定された 凝集による粒子の数濃度の経時変化の例。

や粒径分布の経時変化を測定し、実験値と式 (2)-(4)やそれらの解をフィッティングする ことで、凝集速度定数を求めることができる。 コロイド粒子やフロックの数濃度や粒径の分布 は、顕微鏡観察を通して、所定の体積中に存在 する粒子やフロックの数と大きさを測定するこ とで得られる。粒子の数濃度の変化が直接わか るので、そのままで速度定数の絶対値を得るこ とができる。ただし、この方法は粒子を一つ一 つ数えたり大きさを測ったりするために時間の かかる作業となる。また通常の顕微鏡で粒子を 見ることができるサイズの限界は 0.5 µm 程度 であり、これより小さな粒子には適用できない。

分散系の粒子数を自動でカウントする装置と してコールターカウンター[®]に代表される電気 的検知帯方式のものがある。コールターカウン ターの検出部はアパチャーと呼ばれる微細な孔 を持つチューブとその内側及び外側に設置され た電極から構成されている。測定ではチューブ の内側を吸引して外側にあるコロイド懸濁液を 内側に所定の容量だけ吸引する。この際、コロ イド粒子がアパチャーを通過すると粒子の大き さに依存して電極間の電気抵抗が変化する。コー ルターカウンターでは、この電気抵抗の変化を 処理することによってアパチャーを通過したコ ロイド粒子の数と大きさを求める。検出できる



Fig. 10 凝集による吸光度の経時変化の例。 吸光度は濁度に比例する。

粒子径はアパチャー径の2から80%である。測 定にあたっては懸濁液を電解質溶液で希釈する 必要がある。Fig.9にコールターカウンターに よって得られた、凝集によって粒子の数濃度が 低下していく様子を示す。このような数濃度の 変化の様子から速度定数を求める。

6.2 光学的方法

凝集が進行すると粒子径の分布が変化し懸濁 液の濁度 τ が変化する(Fig. 10)。凝集の初期 段階では、懸濁液中には1次粒子と2次粒子の みが存在すると仮定すれば、濁度変化 $d\tau/dt$ は

$$\frac{d\tau}{dt} = C_1 \frac{dn_1}{dt} + C_2 \frac{dn_2}{dt}$$
(16)

で与えられる¹⁰⁾。ここで C_1 、 C_2 は 1 次粒子、 2 次粒子の吸光断面積である。式(16)に式(2)、 (3)を代入し初期濁度 $\tau_0 = C_1 n_0$ で除すと

$$k_{\rm il} = \frac{(d\tau/dt)/\tau_0}{Fn_0} \tag{17}$$

$$F = \frac{C_2}{2C_1} - 1$$
 (18)

が得られる。凝集により濁度が増加するか減少 するかは光学因子 Fの符号に依存する。式(17) より、初期粒子数濃度 n_0 と光学因子 Fを知り、 濁度の時間変化 $d\tau/dt$ を測定すれば凝集速度定 数 k_1 を求めることができる。最近まで 2 次粒 子の吸光断面積は、粒径が光の波長よりも小さ い場合や2次粒子を球と仮定するなど、限られ た条件においてのみ算出されてきた。そのため 濁度法では任意の条件で凝集速度定数の絶対値 を求めることができず、相対的な凝集速度であ る安定度比を求めることしかできなかった。近 年になり T-matrix 法を用いることにより、任 意の粒径・波長・溶媒において 2 次粒子のまま の吸光断面積を計算することができるようにな り、より正確な F の値を計算できるようになっ た。結果として、汎用性のある分光光度計を用 いた簡便な濁度測定であっても、正確な kuの 絶対値の見積が可能になっている¹⁰。同様に静 的光散乱法 (SLS) においても、レーザー光の 波長 λ と散乱角 θ で定義される散乱ベクトル $q = (4\pi/\lambda)\sin(\theta/2)$ のある値において、散乱 強度 I(q) の時間変化と1次粒子、2次粒子の 散乱強度 I1、I2 から、ku を求めることができ る"。

$$k_{11} = \frac{(dI(q)/dt)/I_0(q)}{[I_2(q)/(2I_1(q))-1]n_0}$$
(19)

動的光散乱法 (DLS) を用いると凝集による 粒径の増加過程を測定することができる (Fig. 11)。動的光散乱法では、懸濁液にレーザー光 を入射し、粒子のブラウン運動による散乱光強 度のゆらぎを解析し、粒子の拡散係数を求め、 拡散係数からストークスアインシュタインの式 により流体力学的な半径 *R*^A を求める。凝集の 初期段階では、DLS によって得られる粒径の 増加速度 *dR*^A/*dt* は次のように書けるⁿ。

$$\frac{1}{R_{h}(0)} \frac{dR_{h}(t)}{dt} = \frac{I_{2}}{2I_{1}} \left(1 - \frac{R_{h,1}}{R_{h,2}}\right) k_{11} n_{0} \quad (20)$$

ここで、 R_{h_1} 、 R_{h_2} は1次粒子、2次粒子の流体力学的半径であり、理論的には $R_{h_2}=1.38$ R_{h_1} の関係がある。流体力学的半径の時間変化 dR_{h}/dt を実験により求め、1次粒子、2次粒 子の散乱強度の比 I_1/I_2 と流体力学的半径の比 R_{h_1}/R_{h_2} をともに評価できれば、 k_{11} を求める ことができる。

式(19)と式(20)を組み合わせると



Fig. 11 動的光散乱法により測定された凝集に よる流体力学的半径の増加の例。





$$\frac{\frac{dI(q, t)/dt}{I(q, 0)}}{=\left(\frac{R_{h,2}}{R_{h,2}-R_{h,1}}\right)\frac{dR_{h}(t)/dt}{R_{h}(0)}-k_{11}n_{0} \qquad (21)$$

が得られるⁿ。複数の散乱光ディテクターを使用 する静的動的同時光散乱法 (SSDLS) を利用す ると、いくつかの散乱角において (dI/dt)/I(0)と $(dR_h/dt)/R_h(0)$ を測定することができる (Fig. 12)。様々な散乱角における dI(q, t)/dtと $dR_h(q, t)/dt$ の関係をグラフにプロットし、 式(21)によって線形近似すると、直線の切片と 傾きから k_{11} とともに $R_{h,2}/R_{h,1}$ の値が得られる。 SSDLS 法では 2 次粒子の光学的・流体力学的 特性を評価する必要がない利点があるが、 高 価な装置が必要となる。



 Fig. 13
 サルフェイトラテックスの電気泳動移動

 度(EPM)と電解質濃度の関係。記号は

 実験値¹⁹、破線はスモルコフスキー理論

 による計算値、実線は緩和効果を考慮し

 た Ohshima の式による計算値を示す。

荷電・凝集の基礎理論のモデル粒子 への適用性

以下に具体的な対象として、ラテックス粒子 とシリカ粒子の荷電・凝集挙動の特徴と理論の 適用性についてのべる。これらの粒子は球形で 単分散性に優れているため、代表的なモデルコ ロイド粒子と考えられる。

7.1 ラテックス粒子の荷電と凝集

Fig. 13 に表面電荷密度が pH やイオン強度 によらず一定のサルフェイトラテックス粒子の 1:1型電解質溶液中における電気泳動移動度 (EPM)の実験結果と計算結果を示す。図中の 記号は Behrens ら¹⁷ によって得られた実験結 果であり、異なる記号は表面電荷密度の違いに 相当している。図中の実線は電気二重層の緩和 効果を考慮した Ohshima の理論¹³⁾ による計算 値、破線は式(11)のスモルコフスキー理論によ る計算値である。計算では図中に示されている それぞれ一定の値の表面電荷密度が使用されて おり、式(12)により表面電位が計算されている。 なおここでは表面電位とゼータ電位は等しいこ とが仮定されている。破線と実線は、電解質濃



 Fig. 14
 サルフェイトラテックスの安定度比(W)

 と電解質濃度の関係。記号は実験値^{ID}、

 実線は DLVO 理論による計算値を示す。

度の高いところでは一致するものの、低い電解 質濃度においては差が生じている。緩和効果を |考慮した理論では電解質濃度と EPM との関係 には極値が存在しており、スモルコフスキー理 論では電解質濃度の低下とともに EPM の絶対 値は単調に増加している。この差の要因は拡散 電気二重層の緩和効果によるものであり、電解 質濃度の低い領域では緩和効果を無視すると理 論値と実験値は一致しない。また、緩和効果の ために、低い電解質濃度では電気泳動移動度か らゼータ電位を算出することはできない。Fig. 13 の通り、電気二重層の緩和効果を考慮した 理論を通して計算した EPM は実験結果と良い 一致を示す。同様の結果は2価の対イオンの存 在下においても確認されている²⁰⁾。単に EPM の測定からスモルコフスキー式によってゼータ 電位を算出するのではなく、このような実験と 計算との比較を通して、表面電荷密度の値を評 価することができる。

Fig. 14 には、Fig. 13 のようにして電荷密度 が評価された粒子について、動的光散乱法によっ て得られた安定度比が電解質濃度に対してプロッ トされている。図中の記号は実験値^{ID} であり、 実線はハマカー定数 A=1.3×10⁻²⁰J として DLVO 理論によって計算された値である。表 面電荷密度が低い(-7mC/m²)粒子でも高い (-20mC/m²)粒子でも、実験データは緩速凝 集領域、急速凝集領域、CCCの存在を示して おり、DLVO理論による予測と定性的に一致 する。ただし細かく見ると、電荷密度の高い粒 子においては、上で述べた緩速凝集領域におけ る dlogW/dlogC の理論と実験の良く知られた 矛盾が確認される。一方、電荷密度の低い場合 には、緩速凝集領域においても、理論と実験は 良く一致している。

同様の結果は表面電荷密度が pH とイオン強 度に依存するカルボキシルラテックス¹⁰ につ いても報告されている。カルボキシルラテック スの場合、イオン強度が低くても pH が低い (すなわち表面電荷密度が小さい)と静電斥力 が減少して急速凝集領域になるが、緩速凝集領 域における理論と実験の一致は、やはり pH (すなわち表面電荷密度)とイオン強度が低い 条件において見られ、pH とイオン強度がとも に高いときは理論と実験の良く知られた矛盾が 回復している。緩速凝集領域における安定度比 の理論と実験の一致は Borkovec らの一連の研 究によってはじめて示されたものであり大きな 意味をもっている。彼らはこの一致が得られた 理由として、相互作用ポテンシャルエネルギー の障壁の存在する位置の重要性を指摘している。 すなわち、エネルギー障壁が存在する表面間距 離が nm 程度よりも大きいときには理論と実験 は一致し、nm 未満になるとずれが生じること を見出した。表面間距離が nm 未満になると分 子の大きさや表面の不均一性の影響を無視でき なくなり、連続体を想定している DLVO 理論 では実験結果を説明できなくなったと考えられ る。この解釈は表面間力の直接測定で得られた 結果とも矛盾しない。凝集速度の面からも、 DLVO 理論は表面間距離が nm よりも短い領 域を除いて妥当であることが確かめられたこと になる。

なお急速凝集速度定数 k₁の絶対値について も、緩速凝集領域のようにオーダーの違いでは ないが、理論値と実験値には数倍のずれが生じ ている^{& 10}。Adachi[®] は粒子数濃度が高くなる ほど理論と実験は一致するようになると指摘し ているが、明確な説明はいまのところ与えられ ていない。

7.2 シリカ粒子の荷電と凝集^{9,21)}

シリカの表面電荷密度σは、表面に存在す るシラノール基 (SiOH)の脱プロトン化反応

 $-SiOH \stackrel{\&}{\leftarrow} -SiO^- + H^+$ (22) によって決まり、pH やイオン強度に依存する。 シリカの荷電挙動は次の 1pK basic Stern モデ ル²⁰ により記述される。まず、表面電荷密度 は表面での SiO- の濃度 Γ_{sso} - より

σ=-eГ_{sio}- (23) で与えられる。表面での SiOH と SiO⁻ の濃度 (Γ_{sion} と Γ_{sio}-)の和である反応基の全濃度 Γ は 一定

 $\Gamma = \Gamma_{SiOH} + \Gamma_{SiO}$ (24)

であり、両者の比は質量作用の法則

$$\frac{10^{-pH} \exp\left(-\frac{e\Psi_0}{k_B T}\right)\Gamma_{sio}}{\Gamma_{sioH}} = 10^{-pK}$$
(25)

により 1 つの酸解離定数 K、言いかえれば $pK(=-\log_{10}K)$ によって決まる。 1pK basic Stern モデルでは表面近傍にキャパシタンス C。 を持つ Stern 層と呼ばれる層の存在を仮定する (Fig. 15)。この層のために表面近傍において 電位は表面電位 Ψ_0 から Stern 層の外縁の電位 (拡散層電位) Ψ_4 に次のように変化する。

 $\sigma = C_s(\Psi_0 - \Psi_d)$ (26) 拡散電気二重層は Stern 層の外縁から溶液側に 向かって発達する。lpK basic Stern モデルでは イオンの特異吸着を考えないので、1:1型の 電解質溶液中では、表面電荷密度 σ と拡散層 電位 Ψ_d は

$$\sigma = \frac{2k_B T \varepsilon_r \varepsilon_0 \kappa}{e} \sinh\left(\frac{e \Psi_d}{2k_B T}\right) \tag{27}$$

で結ばれる。*pK、Г、С*。を決定し、式(23)~ (27)を連立させて解くことにより、任意の pH、 電解質濃度における表面電荷密度を計算するこ とができる。さらに拡散電気二重層内の電位分



Fig. 15 Stern 層を考慮した電気二重層モデル の模式図。

布を表す式

$$\zeta = \frac{4k_BT}{e} \operatorname{arctanh} \left[\exp(-\kappa x_s) \operatorname{tanh} \left(\frac{e\Psi_d}{4k_BT} \right) \right]$$
(28)

を使用することでゼータ電位を計算し、電気泳 動移動度を求めることができる。

Fig. 16 にシリカの表面電荷密度の実験値 (記号)と計算値(線)を示す。荷電挙動の計 算パラメータについては、既往²⁰ に確認され ている pK ≒ 7.5、Cs=2.9F/m²、 Γ=8/nm² が 使用されている。これらの図の通り、荷電挙動 の pH 依存性の計算結果と実験結果は良好な一 致を示している。使用されたパラメータの値は 複数のシリカ粒子について妥当であることが確 認されているが、球形度と単分散性にすぐれた Stober 法によって合成されたシリカ粒子につ いては、この粒子が極めて大きな荷電量をもっ ているために適用できない。これは Stober シ リカが粒子内部にミクロポアを有していること を示唆している。Stober シリカを800℃で加 熱するとミクロポアは消失し荷電挙動は通常の シリカに対するパラメータで記述できるように なる21.23)。



 Fig. 16
 シリカの表面電荷密度と pH の関係。図中の数字はイオン強度、記号は実験値²¹⁾、 実線は計算値である。



 Fig. 17
 シリカの電気泳動移動度とpHの関係。

 図中の数字はイオン強度、記号は実験
 値²¹⁰、実線は計算値である。

Fig. 17 にはシリカの電気泳動移動度 (EPM) の実験値 (記号) と計算値 (線) を示す。EPM の計算値は、1pK basic Stern モデルで拡散層 電位 Ψ_a を計算し、すべり面までの距離 x_s を $0.25\sim0.5$ nm と想定して式(28) でゼータ電位 を計算し、緩和効果を考慮した理論で EPM を 計算している。図の通り理論と実験は良く一致 している。また、使用された x_s の値の範囲も 水和イオン半径²⁰ のオーダーに近く、無理の



Fig. 18 DLVO 理論によるシリカの凝集速度定 数の計算値と pH の関係。



Fig. 19 動的光散乱法により測定された直径 50 nm のシリカの凝集速度定数 k₁₁ と pH の関係[®]。

ない値と考えられる。

以上のような実験と理論の比較によってチュー ニングされた荷電挙動をもとに、ハマカー定数 A=8.3×10⁻²¹J として DLVO 理論により計算 されたシリカの凝集挙動は Fig. 18 のようにな る。図の通り、計算により得られたシリカの凝 集速度定数 k_{11} の値は pH (すなわち表面電位) が低く電解質濃度が高いほど大きくなっている。 ところ がFig. 19 に示す、動的光散乱法によっ て得られた直径約 50 nm のシリカナノ粒子の K Cl 溶液中での凝集速度定数の実験結果を見 ると、DLVO 理論とは定性的にすら異なる挙 動を示すことが見て取れる。すなわち、pH が 高く電解質濃度も高いときには急速凝集領域に



Fig. 20 動的光散乱法により測定された 800 ℃で 加熱したシリカの安定度比と pH の関係。 図中の数字はイオン強度、記号は実験 値²¹⁰、実線は計算値である。

相当する部分が見られるものの、pH の低い領 域では1Mの高塩濃度においてすら凝集しない。 このシリカに関する DLVO 理論と実験の矛盾 は古くから知られており、DLVO 理論では考 慮されていない付加的な反発力の存在を考慮す る必要性を示唆している。付加的な反発力は、 シリカ表面にポリマー様のケイ酸がひげ状(あ るいはゲル状)の層として存在し、それが重な り合って生ずる立体安定効果によるものと考え られる^{25, 20)}。この低 pH 側におけるシリカの異 常な安定性は粒子径が小さくなるほど顕著であ る。これはひげ状(あるいはゲル状)の層が粒 径に対して相対的に厚くなることによると考え られる。しかしながらシリカの付加的な斥力の 正体についてはいまだに十分明らかとは言えな い。今後さらなる実験研究が必要である。

ミクロポアを消失させるために 800 ℃ で加熱 した Stober シリカの安定度比を Fig. 20 に示 す。加熱したシリカでは理論(記号)と計算 (線)は良く一致している。これは加熱により、 ひげ状(あるいはゲル状)の層が消失し、付加 的な斥力が除去されたためだと考えられる。以 上のことから球状のシリカをモデルコロイド粒 子として使用する場合には加熱が必要であると



Fig. 21 1mM の1:1型電解質溶液中におけるシ リカの表面電位とpH の関係。記号はコ ロイドプローブ原子間力顕微鏡によるシ リカ表面間の力の直接測定から推定され た実験値、実線は 1pK basic Stern モデ ルによる計算値である。●、▲、◆は異 なる研究者によるデータに相当する。実 験データは Serr^mより抜粋。

言える。ただし、加熱したシリカであっても水 と接触することで徐々に電荷の量が増えてくる エイジング効果が報告されている²³⁾。この点に 関する注意とエイジングの実態を検討していく ことも今後、必要である。

付加的な非 DLVO 力に加えて、表面電位の 実態についてもまだ問題が残されている。近年 ではコロイドプローブ原子間力顕微鏡(AFM) 法により、シリカ表面間の静電斥力と表面間距 離の関係が直接得られている²⁷。直接測定によ る力と表面間距離の関係を DLVO 理論でフィッ ティングすると表面電位を推定できる。ところ がコロイドプローブ AFM 法による表面間力の 直接測定から見積もられた表面電位と表面電荷 密度や電気泳動、安定度比を記述できる 1pK Basic Stern モデルから見積もられた表面電位 とは必ずしも一致しない (Fig. 21)。この不一 致は、表面の粗さや構造、電位の定義される位 置の差異、イオンの特異吸着などが原因と考え られる。この不一致の要因を明らかにすること も重要な課題である。

8. おわりに

微粒子の凝集速度と関連する荷電挙動を考え る上での基本理論について解説し、理論のラテッ クス粒子とシリカ粒子への適用性について紹介 した。今後は表面電荷密度が大きい場合に生ず る緩速凝集領域における理論と実験とのずれや 急速凝集速度定数の理論と実験の不一致を説明 するアイデアが必要となる。また、シリカ粒子 では荷電や界面動電現象から評価される表面電 位と粒子間力の直接測定から見積もられる表面 電位とのずれの要因を明らかにする必要がある。 さらに、実際面ではコロイド粒子は流れの中で 凝集する。流れと静電力が凝集に与える効 果^{14, 20)} を系統的に検討していく必要がある。

引用文献

- 日本粉体工業技術協会編: "凝集工学",日 刊工業新聞社 pp.1-30.(1982)
- 日本粉体工業技術協会編:"微粒子工学", 朝倉書店 pp. 198-205. (1994)
- 3) 足立泰久: 色材, 82, 306(2009).
- 4)足立泰久,岩田進午編:"土のコロイド現象",学会出版センター pp. 175-199.
 (1982)
- 5)足立泰久,岩田進午編:"土のコロイド現 象",学会出版センター pp. 82-91.(1982)
- 6) 足立泰久,岩田進午編:"土のコロイド現 象",学会出版センター pp.157-173. (2003)
- 7) H. Holthoff, S. U. Egelhaaf, M. Borkovec, P. Schurtenberger and H. Sticher: *Langmuir*, 12, 5541(1996).
- Y. Adachi: Adv. Colloid Interface Sci., 56, 1 (1995).
- 9) M. Kobayashi, F. Juillerat, P. Galletto, P. Bowen and M. Borkovec: *Langmuir*, 21, 5761 (2005).
- S. H. Behrens, D. I. Christl, R. Emmerzael, P. Schurtenberger and M. Borkovec, *Langmuir*, 16, 2566 (2000).

Vol.45 No.11(2010)

- P. C. Hiemenz and R. Rajagopalan: "Principles of Colloid and Surface Chemistry", 3rd ed., Marcel Dekker pp. 499-624. (1997)
- M. Elimlech and C. R. O'Melia: Colloids Surfaces, 44, 165 (1990)
- 13)北原文雄,古澤邦夫,尾崎正孝,大島広行: "ゼータ電位",サイエンティスト社, pp. 3-32. (1995)
- 14) K. Kim, Y. Nakayama and R. Yamamoto: Phy. Rev. Lett., 96, 208302 (2006)
- 15) R. W. O'Brien and L. R. White: J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, 74, 1607 (1978)
- 16) M. Borkovec and S. H. Behrens: in
 "Encyclopedia of Surface and Colloid Science", Marcel Dekker pp. 4795-4805. (2002)
- S. Behrens, M. Borkovec and M. Semmler: *Progr. Colloid Polymer Sci.*, 110, 66 (1998)
- 北原文雄,古澤邦夫: "分散・乳化系の化 学",工学図書,pp.131-134. (1979)
- 19) Z. Sun, J. Liu and S. Xu: Langmuir, 22, 4946 (2006)
- M. Kobayashi: Colloid Polymer Sci., 286, 935 (2008)

- M. Kobayashi, M. Skarba, P. Galletto, D. Cakara and M. Borkovec: J. Colloid Interface Sci., 292, 139 (2005)
- 22) T. Hiemstra, J. C. M. de Wit and W. H. van Riemsdijk: J. Colloid Interface Sci., 133, 105 (1989)
- 23) J. D. Wells, L. K. Koopal and A. de Keizer: Colloids Surfaces A, 166, 171 (2000)
- 24) 大瀧仁志:"イオンの水和", 共立出版, (1990) p. 59.
- 25) J. A. Kitchener: Faraday Discuss., 59, 379 (1971)
- G. Vigil, Z. Xu, S. Steinberg and J. Israelachivili, J. Colloid Interface Sci., 165, 367 (1994)
- 27) A. Serr: "Interaction Forces of Poly (styrenesulfonate)-Covered Surfaces Measured by Direct Force Spectroscopy", diploma thesis, University of Bielefeld (2003)
- 28) M. Kobayashi, T. Maekita, Y. Adachi and H. Sasaki: *International J. Mineral Process.*, 73, 177 (2004)
- 29) D. Sato, M. Kobayashi and Y. Adachi: Colloids Surfaces A, 266, 150 (2005)